3　試験結果の記載方法

三及び四の測定で得られた試験機器の各状態における比吸収率測定値の最大値をW／kg単位で記載し、ファントム外殻の座標位置に対する比吸収率（測定値）の分布をグラフ等で記載すること。

4　その他の条件

三の４に準ずる。

五　比吸収率の測定⑶　複数帯域同時送信時の測定

1　測定系統図

三の１に準ずる。

2　測定操作手順

複数帯域同時送信時において、プローブ較正又はファントム液剤の有効な周波数範囲を超える周波数で同時送信する場合は、次のいずれかの方法により測定する。

⑴　比吸収率の和を複数帯域同時送信時の比吸収率とする方法

ア　複数帯域同時送信時において同時に送信される複数の送信周波数帯それぞれについて、三及び四の方法により比吸収率を測定する。

イ　アにより得られた比吸収率について、送信周波数帯に係る試験条件以外を同じくする比吸収率の和の値を求める。

ウ　イにより求めた値のうち最大のものを複数帯域同時送信時の比吸収率とする。

⑵　最大の比吸収率を複数帯域同時送信時の比吸収率とする方法

ア　複数帯域同時送信時において同時に送信される複数の送信周波数帯それぞれについて、三及び四の方法により比吸収率を測定する。

イ　アの過程で得られる全ての比吸収率の二次元的な分布のうち、最大となる比吸収率の値及び当該比吸収率の位置を記録する。

ウ　イにより記録した位置における送信周波数帯に係る試験条件以外を同じくする比吸収率の和の値を求める。

エ　ウにより求めた値がイにより記録した値の＋５％以内である場合はアにより測定した比吸収率のうち最大の値を複数帯域同時送信時の比吸収率とし、その他の場合は⑴、⑶又は⑷の方法により複数帯域同時送信時の比吸収率を求める。

⑶　三次元計算による比吸収率を複数帯域同時送信時の比吸収率とする方法

ア　複数帯域同時送信時において同時に送信される複数の送信周波数帯それぞれについて、三及び四の方法により比吸収率を測定する。

イ　アの過程で得られる全ての比吸収率の二次元的な分布から空間的な分布を算出し、送信周波数帯に係る試験条件以外を同じくする空間的な分布を足し合わせる。

ウ　イにより足し合わせた比吸収率の空間的な分布のうち、最大となる比吸収率を複数帯域同時送信時の比吸収率とする。

⑷　立方体走査による比吸収率を複数帯域同時送信時の比吸収率とする方法

ア　複数帯域同時送信時において同時に送信される複数の送信周波数帯それぞれについて、三及び四の方法により比吸収率を測定し、当該比吸収率の位置を記録する。

イ　アにより記録した位置の全てを含む立方体領域を設定する。

ウ　複数帯域同時送信時において同時に送信される複数の送信周波数帯それぞれについて、イにより設定した立方体領域内の比吸収率の分布を測定する。

エ　ウにより測定した比吸収率の分布について、送信周波数帯に係る試験条件以外を同じくする比吸収率の分布を足し合わせ、最大となる比吸収率を複数帯域同時送信時の比吸収率とする。

3　試験結果の記載方法

複数帯域同時送信時の比吸収率の最大値をW／kg単位で記載し、ファントム外殻の座標位置に対する比吸収率（測定値）の分布をグラフ等で記載すること。

4　その他の条件

三の４に準ずる。

第二　人体頭部における比吸収率（ＳＡＲ）の測定方法

一　一般事項

1　試験場所の環境

⑴　室内及びファントム液剤の温度は、18℃から25℃までの範囲内とすること。

⑵　比吸収率の測定を行っている間のファントム液剤の温度変化は±２℃を超えず、かつ、電気的特性の変動は±５％以内であること。

⑶　試験機器及び測定装置等が周囲の電磁波の影響を受けないこと。この場合において、周囲のノイズからの影響を、10グラム平均局所比吸収率で0.012W／kg以下とすること。

⑷　制御局シミュレータ、床、位置決め装置等からの反射の影響は、10グラム平均局所比吸収率で0.012W／kg未満とすること。ただし、反射の影響がこれを超える場合であって、当該反射の影響を不確かさに追加したときは、この限りでない。

2　測定装置

⑴　比吸収率測定装置

ア　電界プローブ

㋐　電界プローブは、電界強度の測定値から算出される比吸収率の最小検出値が0.01W／kg以下、最大検出値が100W／kg超を検出できるものであること。

㋑　プローブ先端の直径は、２GHz以下の周波数においては８㎜以下、２GHzを超える周波数においてはファントム液剤中の当該周波数の波長の１／３以下であること。

イ　プローブ走査装置

㋐　測定範囲に対する電界プローブ先端の位置決めの精度は、各走査位置について±0.2㎜以下であること。

㋑　位置決めの分解能は１㎜以下であること。

㋒　ファントム上の少なくとも３点の参照点を用いてファントムと関連付けられること。この場合において、これらの点は、20㎝以上離して配置すること。

ウ　保持器

保持器材質の誘電正接（ｔａｎδ）は0.05以下、保持器材質の比誘電率の実部（ε_r）は５以下であること。

⑵　ファントム外殻

ア　形状及び寸法は、ＩＥＣ62209―１に規定するファントム外殻に対して±0.2㎜未満の公差を保つこと。

イ　ファントム外殻の表面の位置決めの基準点右耳の位置（以下「ＲＥ」という。）、左耳の位置（以下「ＬＥ」という。）及び口の位置（以下「Ｍ」という。）が分かるように印が付されていること。

ウ　外殻材質の誘電正接（ｔａｎδ）は0.05以下、外殻材質の比誘電率の実部（ε_r）は、３GHz以下の周波数においては５以下、３GHzを超える周波数においては２以上５以下であること。

エ　外殻の厚さは、試験機器の投影面のいかなる箇所においても、２±0.2㎜であること。ただし、耳については、試験機器を押し当てた状態を再現し、基準点（ＲＥ及びＬＥ）において、６±0.2㎜の耳翼モデルであること。

⑶　ファントム液剤

ファントム液剤の電気的特性（ファントム液剤の比誘電率の実部及び導電率）の許容値の範囲は、平成25年総務省告示第324号別表⑵に規定する値に対して±10％の範囲内であること。